

GaAs-IR-Lumineszenzdiode

GaAs Infrared Emitter

LD 271

LD 271 H

LD 271 L

LD 271 HL



Wesentliche Merkmale

- GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
- Gehäusegleich mit SFH 300, SFH 203

Features

- Very highly efficient GaAs-LED
- High reliability
- Spectral match with silicon photodetectors
- Same package as SFH 300, SFH 203

Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern
- Gerätefernsteuerungen für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Sensorik
- Diskrete Lichtschranken

Applications

- IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers
- Remote control for steady and varying intensity
- Sensor technology
- Discrete interrupters

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
LD 271	Q62703-Q148	5-mm-LED-Gehäuse (T 1 $\frac{3}{4}$), graugetöntes Epoxy-Gießharz, Lötspieße im 2.54-mm-Raster ($\frac{1}{10}$ "") 5 mm LED package (T 1 $\frac{3}{4}$), grey colored epoxy resin lens, solder tabs lead spacing 2.54 mm ($\frac{1}{10}$ "")
LD 271 L	Q62703-Q833	
LD 271 H	Q62703-Q256	
LD 271 HL	Q62703-Q838	

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	130	mA
Stoßstrom, $t_p = 10 \mu s$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	3.5	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	220	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	330	K/W

Kennwerte ($T_A = 25 \text{ °C}$)
Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$	λ_{peak}	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 100 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 25	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.25	mm ²
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.5×0.5	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip front to lens top	H	4.0 ... 4.6	mm
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100 \text{ mA}$, $R_L = 50 \Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100 \text{ mA}$, $R_L = 50 \Omega$	t_r, t_f	1	μs

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics** (cont'd)

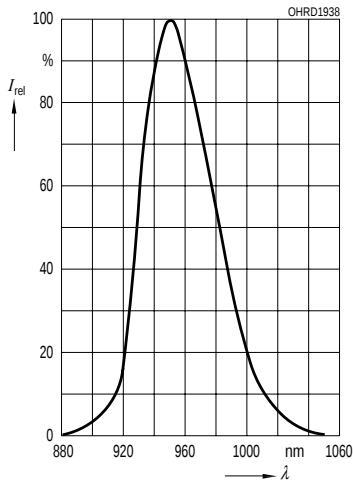
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$ Capacitance	C_0	40	pF
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	V_F V_F	1.30 (≤ 1.5) 1.90 (≤ 2.5)	V V
Sperrstrom, $V_R = 5\text{ V}$ Reverse current	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	Φ_e	18	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_I	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_V	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of λ , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_λ	0.3	nm/K

Gruppierung der Strahlstärke I_e in Achsrichtunggemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01\text{ sr}$ **Grouping of Radiant Intensity I_e in Axial Direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		LD 271 LD 271 L	LD 271 H LD 271 HL	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	I_e $I_{e\text{ typ.}}$	15 (≥ 10) 120	> 16	mW/sr mW/sr

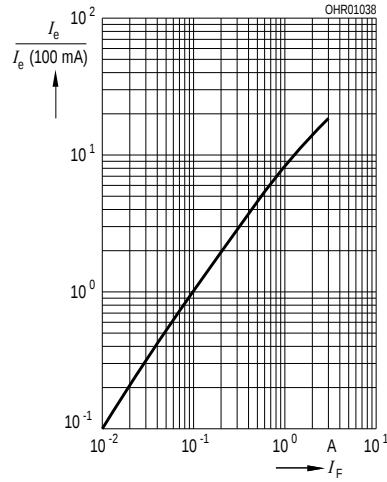
Relative Spectral emission

$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



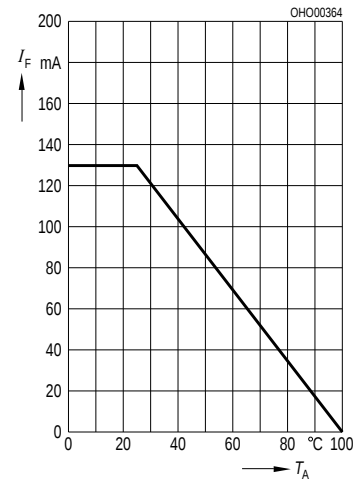
Radiant Intensity $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



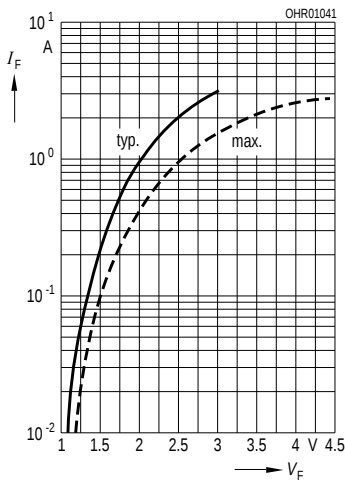
Max. Permissible Forward Current

$$I_F = f(T_A)$$



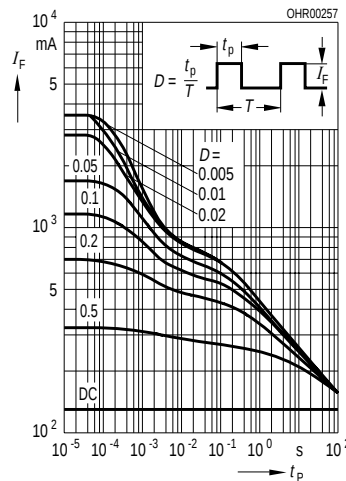
Forward Current

$$I_F = f(V_F), \text{ single pulse, } t_p = 20 \mu\text{s}$$

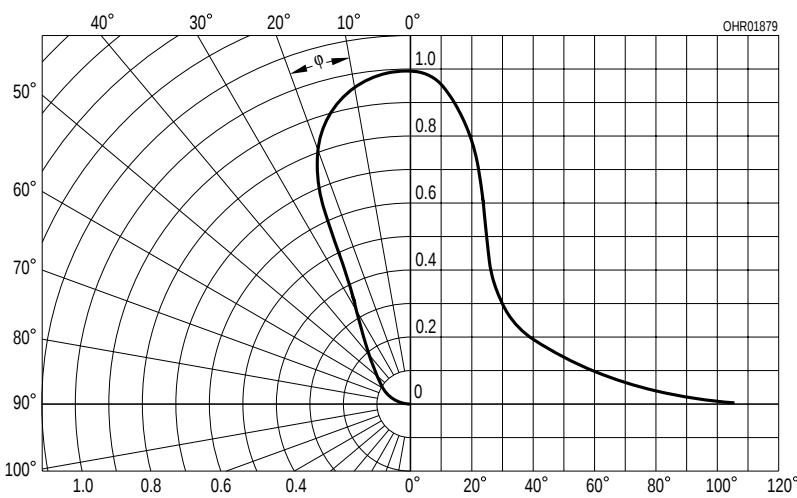


Permissible Pulse Handling Capability

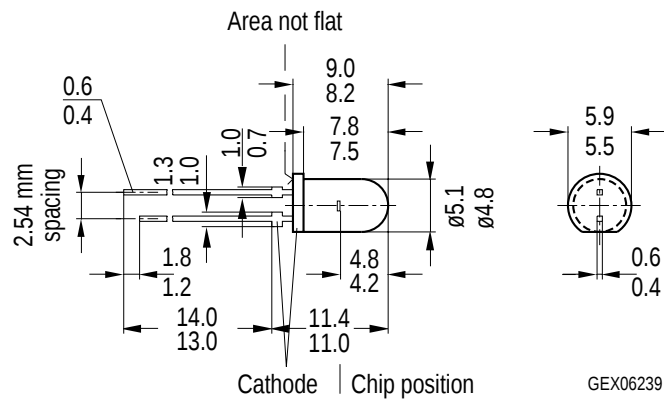
$$I_F = f(\tau), T_C = 25^\circ\text{C}, \text{ duty cycle } D = \text{parameter}$$



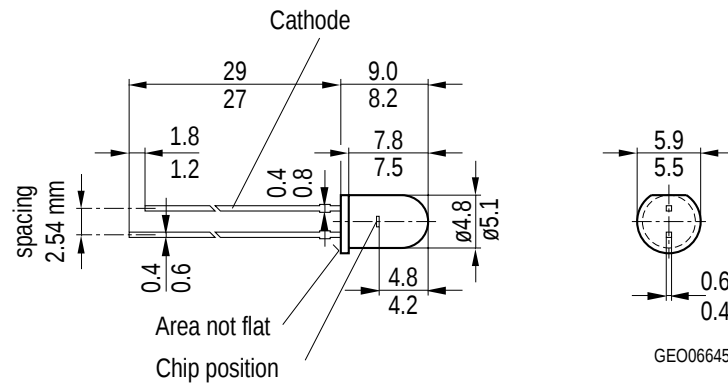
Radiation Characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$



**Maßzeichnung
Package Outlines**



Approx. weight 0.5 g



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified.